HIGH FREQUENCY COIL AND MANUFACTURE THEREOF

Patent number:

JP2126610

Publication date:

1990-05-15

Inventor:

KANO OSAMU; others: 01

Applicant:

MURATA MFG CO LTD

Classification:

- international:

H01F17/00; H01F41/04

- european:

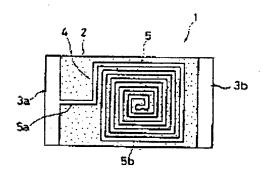
Application number: JP19880280874 19881107

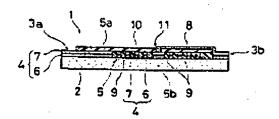
Priority number(s):

Abstract of JP2126610

PURPOSE:To improve size precision, achieve a thicker film one, and improve Q by forming a second coil conductor through plating on the upper surface of a first coil conductor formed on a surface of a base board using thin film technique.

CONSTITUTION: A coil conductor 4 has a two layer structure comprising a first coil conductor 6 formed on an insulator base board 2 by thin film technique, and a second coil conductor 7 formed on the upper surface of the first coil conductor 6 by plating. The conductor 6 is fabricated by forming a metal film, consisting of Ag, etc., on the upper surface of a metal film, consisting of Pd, etc., by thin film technique such as ion plating to form a conductor film, and removing the part except the conductor 4 and terminal electrodes 3a, 3b by etching. The conductor 7 is formed by coating a polyimide or polyamide resin on the base board 2 on the upper surface of the conductor 6 to form an insulator film 9, and removing the upper surface part of the conductor 6 by etching to form an opening, and coating Ag, etc., within this opening by electrolytic plating or electroless plating. Therefore, the coil conductor film can be made thicker and the conductor resistance can be made smaller to improve Q.





⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平2-126610

®Int. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)5月15日

H 01 F

DC

6447-5E 8219-5E

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

会発明の名称

高周波コイル及びその製造方法

②特 頤 昭63-280874

22出 願 昭63(1988)11月7日

明 個発 老

納 加

京都府長岡京市天神2丁目26番10号 株式会社村田製作所

内

個発 明 者 H 生 京都府長岡京市天神2丁目26番10号 株式会社村田製作所

包出 20 人 理

110

株式会社村田製作所

弁理士 下 市 努 京都府長岡京市天神2丁目26番10号

1. 発明の名称

商周波コイル及びその製造方法

- 2. 特許績求の範囲
- (1) 基板の表面にコイル導体をパターン形成し てなる高周波コイルにおいて、上記コイル導体が、 基版の表面に薄膜技術により形成された第1コイ ル導体と、絃箏しコイル導体の上面にメッキによ り形成された第2コイル導体とから構成されてお り、上記基板上の、上記コイル導体以外の部分が ポリイミドあるいはポリアミドからなる絶縁体で 構成されていることを特徴とする高周波コイル。
- (2) 益板の衰団に薄膜状の第1コイル媒体をパ ターン形成し、故コイル導体の上面を覆うように 上記基板の表面にポリイミドあるいはポリアミド からなる絶縁酸をコーティングした後、数絶縁酸 の上記第1コイル導体に対応した所要部分をエッ チング怯により除去し、しかる後核第1コイル耳 体の上面の所要部分にメッキ法により第2コイル 導体を形成したことを特徴とする高周波コイルの

製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(重要上の利用分野)

本発明は、基板上にコイル導体を形成してなる 高周波コイルに関し、特にコイルのQを向上でき るようにした構造及びその製造方法に関する。

(従来の技術)

従来から、コイルとして、金属導体を螺旋状に 巻回してなる空心コイル及びフェライトやアルミ ナ等のポピンに抱練を施してなるポピン巻練コイ ル等がある。しかしこの両コイルは形状が大きく。 特性が不安定であることから、高周波領域では採 用できない。これに対して絶縁体基板の表面に会 **属確膜からなる帯状のコイル導体を形成してなる** 高周波コイルは、部品形状を小型化でき、しかも マイクロ被帯の高周被領域に採用できる。この高 間波コイルを製造する場合は、従来、以下の方法 が採用されている。例えばガラス,セラミックス 製基板の変面全面にスパッタリングあるいは露 法等により A 8 等の金属薄膜を形成し、抜薄膜の

特開平2-126610(2)

上面にコイルパターンに応じた形状 レジスト膜を形成し、これにより上記薄膜の不要部分をエッチングにより除去してコイル媒体を形成する。

(発明が解決しようとする問題点)

ところで、上記従来の高周波コイルにおいては、 コイル事体をスペッタリング等の薄膜技術により 形成することから、このコイル事体の腹厚が薄い 分導体抵抗が大きくなり、Qが低いという問題が あり、このQの向上が要請されている。

ここで、上記 Q を向上させるには、コイル源体の膜厚を厚くして源体抵抗を小さくしてやればよいことが知られている。そこで、上記障膜技術により形成されたコイル媒体の上面に、コイル源体を重ねて形成して膜厚を厚くすることが考えられる。しかしながら練幅、間隔が散十μmと非常に細いコイル導体の上面にコイル導体を特度よく重ねで形成するのは困難であり、結局コイル源体の膜厚を厚くすることは現状では難しい。

本発明は上記従来の状況に鑑みてなされたもので、コイル導体を重ねて形成する際の寸法特度を

形成された第1コイル導体と、放第1コイル導体 の上面にメッキにより形成された第2コイル導体 とで構成し、上記基板上の、上記コイル導体以外 の部分をポリイミドあるいはポリアミドからなる 独縁体で構成したことを特徴としている。

ここで、上記铬緑膜にポリイミドあるいはポリ アミドを採用した理由について説明する。 向上して厚膜化を実現でき、Qを向上できる高順 被コイル及びその製造方法を提供することを目的 としている。

(問題点を解決するための手段)

そこで、本願第1項の発明は、基板の表面にコイル媒体を形成してなる高周波コイルにおいて、 上記コイル媒体を、基板の表面に確認技術により

このポリイミド、ポリアミドは、従来から絶縁 膜として採用されているSiOェ、Si:N。. PSG、SOG等の無機材料に比べ、加工性、量 麼性、及び品質に対する信頼性に優れており、し かも誘電率が小さい。また、感光性を有している ポリイミド、ポリアミドは、これを基板上にコー ティングした後に、また非感光性のものは、ホト レジストをコートした後に、それぞれホトリソグ ラフィーの技術を採用することにより、容易に改 細加工ができる。

また、本発明の高周坡コイルは、基板上に第1. 第2コイル導体及び絶縁膜を一層だけ形成してなる単層のもの、コイル導体と絶縁膜を交互に積層 してなる多層のものが含まれる。

さらに、本発明のコイル導体の形状としては、 例えばスパイラルタイプ、ミアンダタイプ等が考えられ、特に限定されるものではない。

さらにまた、上記第1コイル導体の形成方法と しては、スパッタリング、 蒸着、イオンプレーティグ法等が採用できる。

(作用)

本翻第1項の発明に係る高間被コイルによれば、 基版の表面に薄膜技術により形成された第1コイ ル準体の上面に、メッキにより第2コイル導体を 形成してコイル導体を構成したので、このコイル 準体の腰厚を厚くすることができ、導体抵抗を小 さくしてQを向上できる。

本願第2項の製造方法では、上記第1コイル事体の上面にポリイミド、ポリアミドからなる絶縁限をコーティングして、該絶縁膜の第1コイル導体の厚くしたい部分をエッチングで除去した後、第1コイル導体の上面にメッキ法により第2コイル導体を形成したので、上記エッチングにより絶縁関に後個加工ができるから、この絶縁膜に緩幅の補いコイルパターンに応じた関ロを形成でき、寸法精度を向上できる。

また、予め厚膜の厚体膜を形成し、これをフォ トエッチングしてコイル源体を形成する方法の場 合、コイル導体の側面がエッチングによって侵食 され、寸法物度が出ないという問題があるが、本

8 を介して図面右側の端子電極 3 b に接続されている。

また、上記コイル1の断面状態を示す第2図において、上記コイル導体4は、上記逸縁体基板2に薄膜技術により形成された第1コイル導体6と、接コイル導体6の上面にメッキにより形成された第2コイル導体7とから構成された2階構造となっている。上記第1コイル導体6は、Ti、Cェ・Pd等からなる金属膜を変者・スパッタリングあるいはイオンプレーティング等の薄膜技術により形成して導体膜を形成し、上記コイル導体4より形成して導体膜を形成し、上記コイル導体4及び端子電債3 a . 3 b 以外の部分をエッチングにより除去して形成されたものである。

さらに、上記録2コイル導体7は、上記第1コイル導体6の上面の基板2上にポリイミドあるいはポリアミド樹脂をコーティングして逸縁膜8を形成し、鉄絶縁膜8の第1コイル源体6の上面部分をエッチングにより除去して開口を形成し、この関口内に電解メッキあるいは無電解メッキによ

発明は、メッキ法で第2コイル導体を形成することによって厚膜化する方法であるから、上述のような侵食の問題が生じることはない。

(実施例)

以下、本発明の実施例を図について説明する。 第1図ないし第3図は本発明の一実施例による 高間被コイル、及びその製造方法を説明するため の図である。

まず、本頭第1項の発明の一実施例による高周 彼コイルの構造について説明する。

保護被膜を除いた平面状態を示す第1図において、1は本実施例のチップ型の高周波コイルであり、これはガラス又はセラミックスからなる絶縁体基版2の上面に、膜厚1~20μmの金属膜からなるコイル導体4をパターン形成して構成されている。このコイル導体4は、上記基版2上面の左の右縁郎に形成された嫡子電極3a、3b及び中央部に形成されたスパイラルコイル5からなり、接近コイル5の外端5aは図面左側の端子電極3aに接続されており、内端5bは後述するリード電極

りAg. Cu. Au等を被覆して形成されたもの である。

また、上記コイル事体4の酉幡子電極3.a.3 b 部分を除く落板2上にはポリイミドあるいはポリアミドからなる保護被膜10が形成されており、 抜被膜10のスパイラルコイル5の内端5bを臨む部分にはスルーホール11が形成されている。 さらに、上記保護被膜10の上面にはリード電極8が形成されており、該電極8の一端は上記スルーホール11を介して内端5bに接続され、他端は端子電極3bに接続されている。これにより本実施例の高周彼コイル1が構成されている。

次に、本願第2項の発明の一実施例による上記 高周被コイル1の製造方法を説明する。

第3図(a)ないし第3図(i)は本実施例の製造工程を示す断面図であり、この各図は第2図の中央部分を示す。

① まず、鏡面研磨が施された厚さ0.6 mのガラス基板2の上面に、密着性を向上させるための Ti腺13aをスパッタリング法により形成し、

特開平2-126610(4)

次に該T-I 膜 1 3 a の表面にT 1 . A g を問時に 2 元スパッタリングすることによりT i - A g 膜 1 3 b を形成し、続いてこのT i - A g 膜 1 3 b の表面に再電性の良い A g 膜 1 3 c を同じくスパッタリングにより形成して、3 層構造からなる厚き2200人の導体膜 1 3 を形成する(第 3 図(4))。

② 上記導体験18の上面にレジスト膜12を コーティングし、接レジスト膜12を予めスパイ ラルコイル5及び端子電荷3a,3bに応じてパ ターン設計されたマスクで覆い、これを露光して レジスト膜12の残したい部分に光りを当てる。 これを現像処理してレジスト膜12の不要部分を 除去する(第3図(b))。

②) 次に、上記ガラス基板 2 にエッチング処理を施す。すると上記レジスト膜 1 2 のない部分の 源体膜 1 3 が除去され、練幅40 μ m, 間隔40 μ m の スパイラルコイル 5、 嫡子電価 3 m, 3 b からな る第 1 コイル導体 8 が形成される(第 3 図 (a))。 しかる後、この第 1 コイル導体 6 の上面のレジス ト 腕 1 2 を除去する。

体 6 の上面部分だけにAsメッキ膜が付着して第 2 コイル選体 7 が形成される。これにより、第 1 。 第 2 コイル選体 6 。 7 からなる厚膜状のコイル郷 体 4 が形成されることとなる。

の 次に、上記コイル導体 4 のガラス基板 2 上面に感光性ポリイミド樹脂をコーティングして保護被膜 1 0 を形成し、乾燥させる(第 3 図 回)。そして、この保護被膜 1 0 の、上記端子電極 3 a. 3 b (第 2 図参照)。及びスルーホール 1 1 対応部を除く部分にマスクをかけ、上記の工程と関様の方法にて露光・現像を行う。すると、上記端子電板 3 a. 3 b (第 2 図参照)部分が釋出されるとともに、内端 5 b 部分にスルーホール 1 1 が形成されることになる(第 3 図 の))。

⑤ 最後に、上記保護被膜100上面にスパッタリングにより事体膜を形成し、上記の工程と同様の方法にてリード電極8を形成して上記内語5 bと娘子電極3bを接続する(第3図(1)。これにより、本実施例の1.6×3.2×0.7 mからなる大きさの高周波コイル1が製造される(第1図及

② 続いて、上記ガラス蒸板2の第1コイル導体6の上面に、感光性ポリイミド樹脂からなる絶縁線9を厚さ10μm になるようにコーティングし、乾燥させる(第3図(d))。

⑤ 上記ガラス基板2をシアン化銀浴に浸漬して電解メッキを行う。すると、上記第1コイル導

び第2図参照)。

なお、上記の工程では、スパイラルコイル5の 内端5bと端子電極3bとをリード電極Bで接続 したが、上記両者5b.3bをAu線によるワイ ヤポンディングにより接続し、これをナイロン、 エポキシ樹脂系の接着剤で固定してもよい。

次に本実施例の作用効果について説明する。

本実施例の高周波コイル1によれば、ガラス基板2の上面に第1コイル導体6を形成し、これの上面に第1コイル導体7を形成してコイル導体4を構成したので、例えば1~20gョの厚さからなるコイル導体4を形成することができるから、それだけ事体抵抗を小さくでき、Qを向上できる。これにより、高周波領域、GRZ帯まで自己共振しない小型の平面コイルが得られる。

また、本実施例の製造方法では、第1コイル専体6の上面にポリイミド樹脂からなる絶縁膜9を形成し、これの第1コイル導体6部分をエッチングして開口14を形成し、旗関口14内の第1コイル導体6上にメッキにより第2コイル事体7を

特間平2-126610(5)

形成したので、線幅が縮く厚みの厚いパターン形成する際の微細加工を可能にして寸法精度を向上でき、品質の信頼性を向上できる。

さらに、本実施例では趣味酸9にポリイミドあるいはポリアミドを採用することにより、耐熱性,耐湿性に優れ、かつヒートショック性,耐振動性特性にも優れた部品が得られる。

なお、上記実施例では、ガラス基板 2 上に、コイル事体 4 及び保護被膜 1 0 を一層形成した場合を例にとって説明したが、本発明は上記実施例のコイル 1 において、上記保護被膜 1 0 の上面にさらにコイル事体、絶縁膜を扱う返し形成してなる多層コイルにも適用でき、また上記基板 2 を挟んだ両表面にコイルを形成してなるものにも適用できる。

また、上記実施例では、第1コイル導体6の上 面に絶縁膜9をコーティングした後、エッチング して第1コイル導体6を露出させたが、本発明の 技術思想は、第1コイル導体6の所定の部分を露 出させるようにして、スクリーン印刷などを用い

数絶縁度の所要部分をエッチング法により除去した後、第1コイル事体の上面にメッキ法により第2コイル事体を形成したので、微細加工を可能にして寸技精度の高い、腰厚の厚いコイル事体を形成でき、Qを向上できる効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図ないし第3図は本発明の一実施例による 高周波コイル及びその製造方法を説明するための 図であり、第1図はその平面図、第2図はその断 面図、第3図(4)ないし第3図(1)はそれぞれ製造工 程を示す断面図、第4図は上記実施例の変形例を 示す終視図である。

図において、1 は高周波コイル、2 はガラス基 板 (基板)、4 はコイル事体、6 は第1コイル事 体、7 は第2 コイル事体、9 は絶縁膜である。

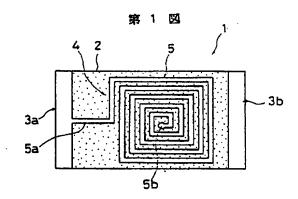
特許出頭人 株式会社 村田製作所 代理人 弁理士 下市 努 て所定の位置にポリイミドあるいはポリアミドからなる始縁膜を形成し、しかる後、メッキにより 第2コイル媒体?を形成する場合も包含するもの である。

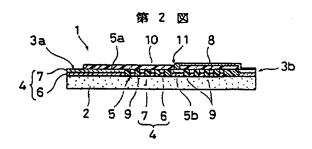
さらに、上記実施例ではスパイラル状のコイル を例にとって説明したが、本発明は勿論これに限 られるものではない。例えば、郭も図に示すよう なミアンダタイプのコイル導体20にも適用でき、 この場合も上記実施例と同様の効果が得られる。

さらにまた、上記実施例では高周彼コイル1を 例にとったが、本発明はコイルとコンデンサとを 組み合わせてなるしCフィルタ、あるいはトラン スなどにも週用できる。

(条明の効果)

以上のように本願第1項の発明によれば、基板の表面に第1コイル導体を形成し、該コイル導体 の上面にメッキにより第2コイル導体を形成して コイル導体を構成し、また第2項の発明による製 澄方法では、上記第1コイル導体の上面にポリイ ミドあるいはポリアミドからなる絶縁膜を形成し、



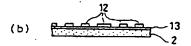


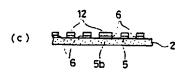
特開平2-126610 (6)

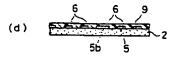
第 3 図(その2)

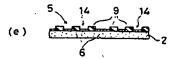
第 3 図(そり1)

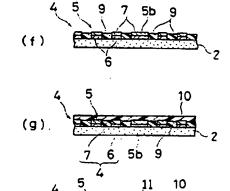


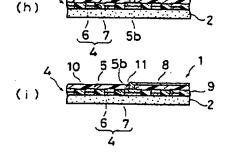












维 4 図

